

Annexe au Doc. NR0422B1
Annex to

(SCR/28/sept. 2003)
(RSC/28/Sept. 2003)

ANNEXE

AMENDEMENT EVENTUEL DE LA NOTE 5 DU CHAPITRE 85

(Point III.A.24 de l'ordre du jour)

ANNEX

POSSIBLE AMENDMENT OF NOTE 5 TO CHAPTER 85

(Item III.A.24 on Agenda)

PROCEDURE DE L'ARTICLE 16
AMENDEMENT DE LA NOMENCLATURE

CHAPITRE 85. Note 5.

Nouvelle rédaction :

“5.- Au sens des n°s 85.41 et 85.42, on considère comme :

- a) Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur, les dispositifs de l'espèce dont le fonctionnement repose sur la variation de la résistivité sous l'influence d'un champ électrique;
- b) Circuits intégrés :
 - 1°) les circuits intégrés monolithiques dans lesquels les éléments du circuit (diodes, transistors, résistances, capacités[, interconnexions] [(multichip package) (boîtier à puces multiples),] etc.) sont créés dans la masse (essentiellement) et à la surface d'un matériau semi-conducteur (par exemple, silicium dopé, arséniure de gallium, silicium-germanium, phosphore d'indium), formant un tout indissociable;
 - 2°) les circuits intégrés hybrides réunissant, de façon pratiquement indissociable, par interconnexions ou câbles de liaison, sur un même substrat isolant (verre, céramique, etc.) des éléments passifs (résistances, capacités, [interconnexions,] [inductances,] etc.), [obtenus par la technologie des circuits à couche mince ou épaisse] et des éléments actifs (diodes, transistors, circuits intégrés monolithiques, etc.) obtenus par la technologie des semi-conducteurs. Ces circuits peuvent inclure également des composants discrets.

Aux fins du classement des articles définis dans la présente Note, les n°s 85.41 et 85.42 ont priorité sur toute autre position de la Nomenclature, à l'exception des n°s 85.23 et 85.24 susceptibles de les couvrir en raison notamment de leur fonction.”

ARTICLE 16 PROCEDURE
AMENDMENTS TO THE NOMENCLATURE

CHAPTER 85. Note 5.

Delete and substitute :

“5.- For the purposes of headings 85.41 and 85.42 :

- (a) “Diodes, transistors and similar semiconductor devices” are semiconductor devices the operation of which depends on variations in resistivity on the application of an electric field;
- (b) “Electronic integrated circuits” are :
 - (i) Monolithic integrated circuits in which the circuit elements (diodes, transistors, resistors, capacitors, [interconnections,] [multichip packages,] etc.) are created in the mass (essentially) and on the surface of a semiconductor or compound semiconductor material (for example, doped silicon, gallium arsenide, silicon germanium, indium phosphide) and are inseparably associated;
 - (ii) Hybrid integrated circuits in which passive elements (resistors, capacitors, [interconnections,] [inductances,] etc.), [obtained by thin- or thick-film technology], and active elements (diodes, transistors, monolithic integrated circuits, etc.), obtained by semiconductor technology, are combined to all intents and purposes indivisibly, by interconnections or interconnecting cables, on a single insulating substrate (glass, ceramic, etc.). These circuits may also include discrete components.

For the classification of the articles defined in this Note, headings 85.41 and 85.42 shall take precedence over any other heading in the Nomenclature, except in the case of headings 85.23 and 85.24, which might cover them by reference to, in particular, their function.”
